



## 156x156 多晶硅片规格书 MULTI-CRYSTAL SILICON WAFER SPECIFICATION

参数 (Parameter)	数值 (Value)	单位 (Unit)
材料类型 (Material type)	多晶/铸锭法 (Multi-crystalline Silicon/Casting)	
外型 (Geometry)	方型 (Square wafer)	
导电类型 (Conductivity type)	P-型 (P-type)	
边长 (Dimension)	156 x 156 ±0.5	mm
倒角 (Corner)	2.0 ±0.5	mm
掺杂物 (Dopant)	B	
电阻率 (Resistivity)	0.5 – 3.0	Ω-cm
氧含量 (Oxygen content)	≤8E <sup>17</sup>	atom/cm <sup>3</sup>
碳含量 (Carbon content)	≤ 9E <sup>17</sup>	atom/cm <sup>3</sup>
少子寿命 (Lifetime)	≥2	μs
方正度 (Square angle)	90±0.5	degree
厚度 (Thickness)	200±20	μm
厚度变化 (TTV)	≤30	μm
弯曲度 (Bow/Warp)	≤75	μm
表面 (Surface)	线切, 表面洁净 (As-cut, cleaned)	
表面损伤 (Surface damage)	切痕 (Saw mark) ≤ 15	μm
表面质量 (Surface quality)	不允许有裂纹, 明显刀痕, 手感不明显, 无沾污和异常斑点 (No crack, no obvious saw mark, no obvious tactility, no abnormal spot, no stain)	
晶界走向 (Grain boundary direction)	晶界走向与硅片表面垂直 (Vertical to wafer surface)	
边缘缺陷 (Edge defect)	深度<0.5mm, 无尖锐边缘 (Depth<0.5mm, total length≤2.0mm, ≤2/w, no sharp edge)	